

**Техническое описание предлагаемой к закупке импортной продукции, включая функциональные характеристики и иные показатели, связанные с определением соответствия импортной продукции требованиям проектной и рабочей документации (ПД и РД).**

Модуль оперативной памяти Kingston KVR1333D3N9/2G (Приложение № 3). Относится к комплектующим ЭВМ, предназначена для хранения машинных кодов и данных, обрабатываемых процессором.

## Модуль оперативной памяти Kingston KVR1333D3N9/2G

### Общие характеристики

Тип памяти - DDR3

Форм-фактор - DIMM 240-контактный

Тактовая частота - 1333 МГц

Пропускная способность - 10600 Мб/с

Объем - 1 модуль 2 Гб

Поддержка ECC - нет

Буферизованная (Registered) - нет

Низкопрофильная (Low Profile) - нет

### Тайминги

CAS Latency (CL) – 9

RAS to CAS Delay (tRCD) - 9

Row Precharge Delay (tRP) - 9

### Дополнительно

Количество чипов каждого модуля - 16, двусторонняя упаковка

Напряжение питания - 1.5 В

